

КРИСТАЛЛОХИМИЯ

УДК 548.736

Посвящается памяти А. В. Шубникова

ТОПОЛОГО-СИММЕТРИЙНЫЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙСТВА $\text{Sr}_2\text{VO}(\text{VO}_4)_2$ С МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ И ПРЕДСКАЗАНИЕ СТРУКТУР С РАЗЛИЧНЫМ УПОРЯДОЧЕНИЕМ ВАНАДИЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

© 2012 г. Е. Л. Белоконева, И. К. Шагивалеева

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

E-mail: elbel@geol.msu.ru

Поступила в редакцию 31.05. 2011 г.

Выполнен тополого-симметрийный анализ структур семейства Sr-ванадил-ванадатов $\text{Sr}_2\text{VO}(\text{VO}_4)_2$ с квазиодномерной спиновой системой, обуславливающей магнитные свойства. На основе известной структуры с пр. гр. $I2/a$ выведены другие структуры, принадлежащие ее подгруппам с упорядоченными ванадильными связями (ВС) в октаэдрах, содержащих магнитный ион V^{+4} . Они отвечают пр. гр. $P2_1/c$, $P2/c$, Pc и структурам с полярной ориентацией ВС в цепочках октаэдров, а также $P2/a$, $P2$ и $P2/n$ с неполярной ориентацией ВС. Во всех структурах рассмотрены варианты разупорядочения ВС в двух направлениях: вдоль оси b и вдоль оси a . Предсказанные структуры могут быть использованы при диагностике полученных фаз в данном семействе, а также как необходимая исходная информация при исследовании магнитных свойств кристаллов.

ВВЕДЕНИЕ

Для проявления кристаллами магнитных свойств необходимо наличие в них “магнитных” ионов, обладающих определенной электронной структурой с нескомпенсированными спинами. Их упорядочение приводит к различным типам магнитных структур: ферромагнитных, антиферромагнитных, ферромагнитных с неравенством магнитных моментов или иных. Особый тип магнитного упорядочения — одномерный — согласно [1], активно исследовался в 90-е гг. В частности, изучалось соединение меди CuGeO_3 , для которого была обнаружена одномерная спиновая система с ионами Cu^{2+} . Квазиодномерные спиновые системы не так давно открыты в кристаллах $\text{Sr}_2\text{VO}(\text{VO}_4)_2$, содержащих один магнитный ион V^{+4} в октаэдрической координации и два других немагнитных иона V^{+5} в тетраэдрической. В октаэдрах имеются укороченные ванадильные связи (ВС), направление и упорядочение которых считается важным при объяснении магнитных свойств [1, 2]. Для соединения $\text{Sr}_2\text{VO}(\text{VO}_4)_2$ определена структура с пр. гр. $I2/a$ [3] со статистическим распределением ВС. В [1] для данного соединения на поликристаллических образцах исследована магнитная восприимчивость, удельная теплоемкость и антиферромагнитное упорядочение при 5.3 К, которое зависело от процесса прокаливания. Результаты исследования магнитных свойств требовали отсутствия центра инверсии в октаэдрах, упорядочения позиций атомов V^{+4} (и соответственно ВС) в структуре и изменения ее пространственной группы. В [4] проведен синтез кристаллов $\text{Sr}_2\text{VO}(\text{VO}_4)_2$ и установлено, что при

длительном отжиге происходит упорядочение катионов V^{+4} с образованием новой структуры, имеющей пр. гр. $P2_1/c$. Для нее приведены параметры ячейки, схематически описано строение и обсуждены возможности существования двух других модификаций без указания их параметров ячеек, пространственных групп и координат атомов. Публикаций по упорядоченным в отношении ВС структурам Sr-семейства, за исключением [4], не имеется.

При исследовании и обсуждении различных магнитных моделей необходима информация о структуре кристалла (параметры ячейки, симметрия, координаты атомов). Таким образом, представляет интерес исследование структурного разнообразия в данном семействе, особенно в отношении распределения ВС в структурах при отсутствии в V^{+4} -октаэдре центра инверсии. В настоящей работе проведен тополого-симметрийный анализ и вывод возможных упорядоченных структур семейства на основе принципа группа—подгруппа. Рассмотрено также разупорядочение ВС за счет сложных чередований при отсутствии центра инверсии в октаэdre. Для каждой предсказанной структуры получены параметры ячеек, пространственные группы и координаты базисных атомов, на основе которых построены рисунки. Обсуждено различное расположение ВС и соотношение структура—свойства.

ПРЕДСКАЗАНИЕ СТРУКТУР В СЕМЕЙСТВЕ

Структуры с полярным упорядочением ВС: пр. гр. $P2_1/c$ $P2/c$ и Pc . В структуре $\text{Sr}_2\text{VO}(\text{VO}_4)_2$ с

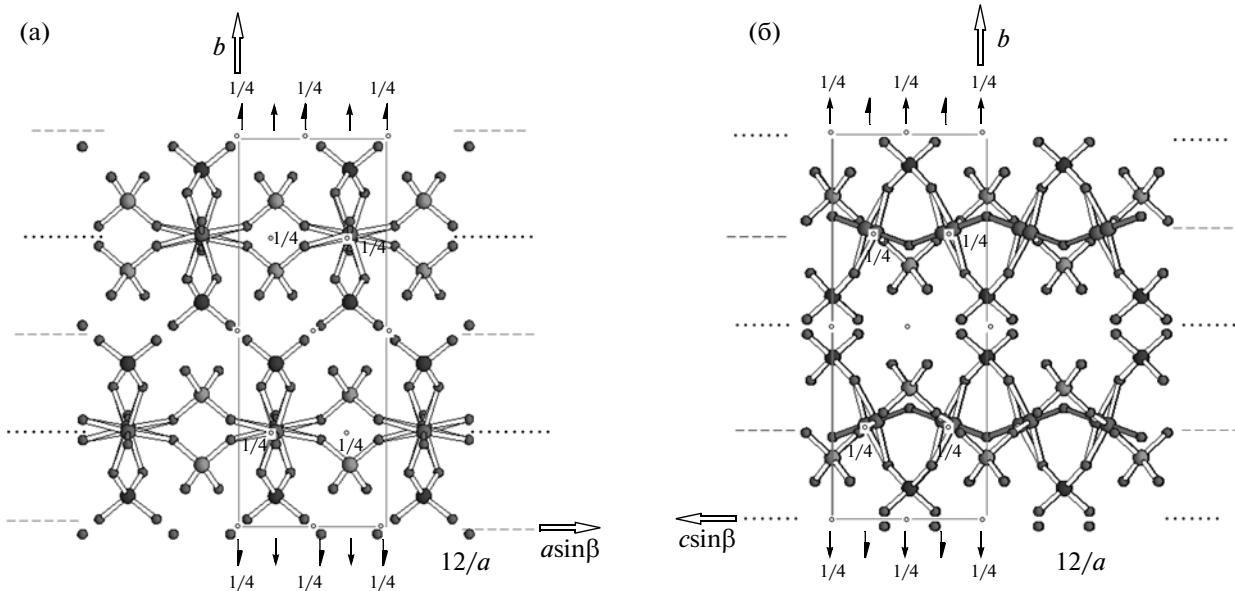


Рис. 1. Кристаллическая структура с пр. гр. $I2/a$, здесь и далее крупные темные шары – атомы V^{+4} в октаэдрической координации, светлые крупные – атомы V^{+5} в тетраэдрах, темные мелкие – атомы О, связи показаны светлыми трубками, а ВС – темными; обозначены элементы симметрии группы; проекция структуры вдоль оси c (а), вдоль оси a (б).

пр. гр. $I2/a$ [3] выделяются цепочки октаэдров V^{+4} , связанных по вершинам. Октаэдры попаременно слегка наклонены к оси цепочки, совпадающей с кристаллографической осью c . Симметрия структуры предполагает расщепление позиции вандильного иона V^{+4} на две близко соседствующие со статистической заселенностью 0.5 с существованием двух противоположных ВС в октаэдре. Соседние цепочки связаны тетраэдрами V^{+5} в VO -слои, лежащие в ac -плоскости, которые разделены вдоль оси b Sr-полиэдрами. Сопоставление обеих структур: разупорядоченной, пр. гр. $I2/a$, и упорядоченной, пр. гр. $P2_1/c$, показывает, что для них выполняется соотношение группаподгруппа. На рис. 1 показаны элементы симметрии надгруппы $I2/a$. Удаление центра инверсии в октаэдрах приводит к исчезновению плоскостей a и результирующих осей 2 и соответственно решетки I , а оставшиеся элементы симметрии отвечают пр. гр. $P2_1/c$ (рис. 2). В новой структуре, построенной по найденным координатам независимых атомов, ВС направлены одинаково в цепочках октаэдров в одном слое (рис. 2в) и противоположно в цепочках в разных слоях (рис. 2б).

Возможность удвоения параметра a , упомянутая в [4], отвечает не простой трансляции цепочек и их ВС в слое, как это имеет место в структуре с пр. гр. $P2_1/c$, а их противоположной ориентации в соседних цепях внутри одного слоя. Она обсуждается в [2] как двойная “*in-phase, F*” и “*antiphase, AF*” ориентация ВС цепочек. Пространственная группа, ячейка и структура такого соединения не определена в [2, 4] и не подтверждена экспери-

ментально [4] при исследовании кристаллов методами рентгеновской, электронной дифракции, а также микроскопии высокого разрешения. Метрика ячейки такой структуры отвечает оси $b_{\text{нов}} = 1/2b_{\text{исх}}$, $a_{\text{нов}} = 2a_{\text{исх}}$ и $c_{\text{нов}} = c_{\text{исх}}$ и пр. гр. $P2/c$ (рис. 3), где вдоль оси $a_{\text{нов}}$ (и ее проекции) между цепочками слоя находятся оси 2 и центры инверсии $\bar{1}$ надгруппы, меняющие последовательно ориентации ВС октаэдров цепочек уже одного слоя. Как справедливо отмечено в [2], неясно, которая из ориентаций (F/AF) доминирует в основном кристалле, поскольку структурные данные не рассматриваются. Закономерное, упорядоченное смещение ионов V^{+4} и соответственно расположение ВС в ячейке отвечают равному соотношению F/AF с их последовательным чередованием и предсказанной структуре с пр. гр. $P2/c$, не рассмотренной ранее, что позволяет “привязать” магнитную модель в [2] к структуре с конкретными кристаллографическими и структурными характеристиками. В то же время можно предполагать структуры с увеличенным более чем вдвое параметром a , если между цепями слоя будут различно чередоваться трансляционные операции симметрии и оси 2 (центры инверсии), т.е. структуры с порядком–беспорядком вдоль оси a . Не исключается доменное строение и для структуры, описываемой пр. гр. $P2_1/c$, с противоположными по упорядочению областями по закону двойника. Подобные структурные соотношения относятся к явлениям порядка–беспорядка и подробно анализируются в теории OD -структур [5].

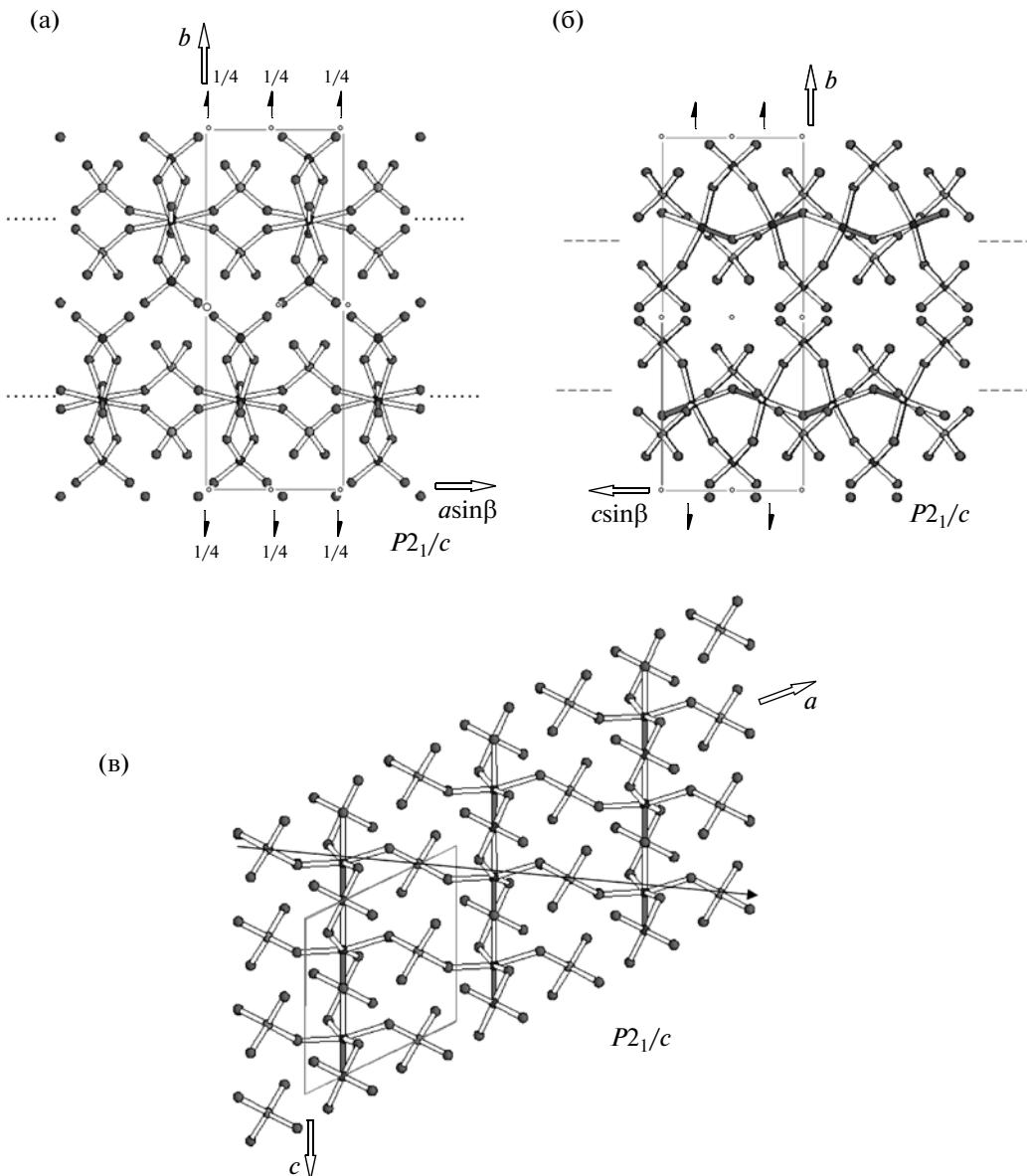


Рис. 2. Кристаллическая структура с пр. гр. $P2_1/c$, проекция структуры вдоль оси c (а), вдоль оси a (б), вдоль оси b ; стрелкой показано направление магнитных цепочек с одинаковой ориентацией ВС в слое (в).

В [4] обсуждается возможность существования триклинической модификации с одинаковой ориентацией ВС в каждом слое и в соседних слоях. В структуре $P2_1/c$ каждая цепочка, а также весь слой, параллельный ac , обладают собственной симметрией Pc . Из этого следует, что при трансформировании такого слоя вдоль оси b будет обеспечено сохранение одинаковой полярной ориентации ВС (а именно, вдоль оси c) в цепочках всех слоев, т.е. в структуре в целом. При этом ось $b_{\text{нов}} = 1/2b_{\text{исх}}$ уменьшится вдвое (она равна толщине одного VO-слоя) при сохранении тех же осей a и c . Симметрия такой структуры моноклинная, пр. гр. Pc , структура показана на рис. 4а. Можно

представить себе более сложную комбинацию из исходной структуры (пр. гр. $P2_1/c$) и новой (пр. гр. Pc) с закономерным их чередованием вдоль оси b . Это обеспечивает утройство параметра $b_{\text{нов}} = 3b_1 = 1.5b_{\text{исх}}$ при сохранении осей a , c ; пространственная группа будет та же: Pc (рис. 4б). Чередования могут быть более сложными, что обуславливает возможный порядок–беспорядок вдоль одного направления в структуре (оси b).

Структуры с неполярным упорядочением ВС: пр. гр. $P2/a$, $P2$ и $P2/n$. Пр. гр. $I2/a$ имеет в качестве подгрупп не только пр. гр. $P2_1/c$, $P2/c$, Pc , но и $P2/a$. Это предполагает существование еще одной структуры с ориентацией ВС соседних октаэдров

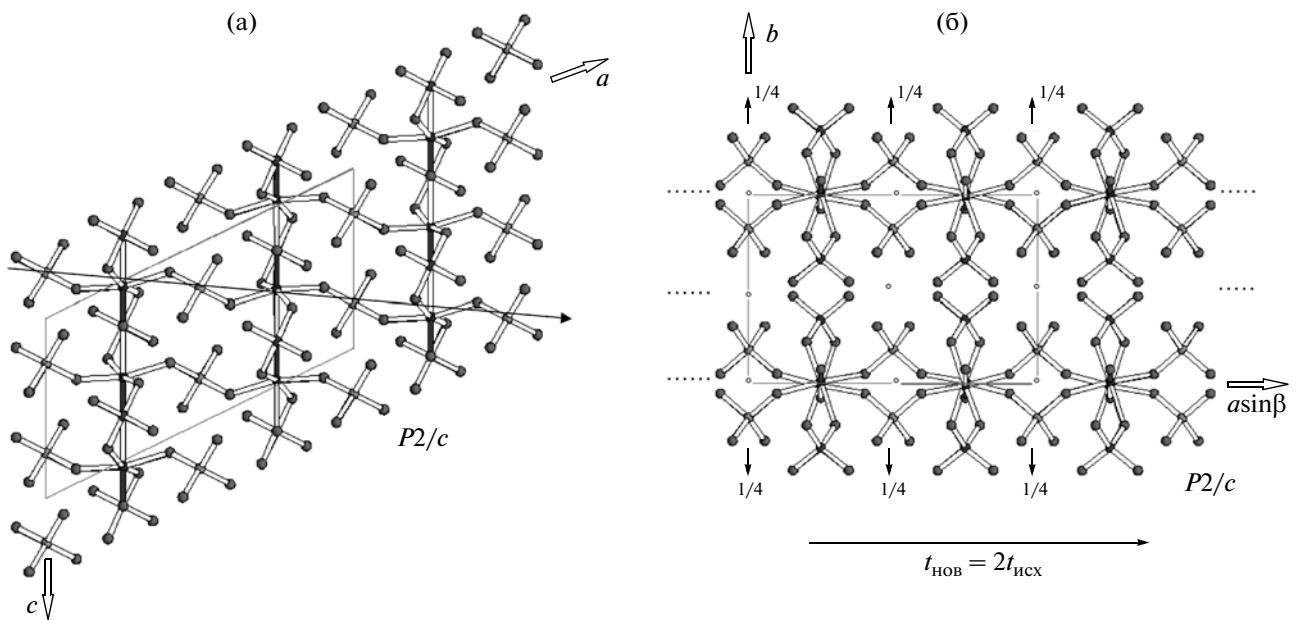


Рис. 3. Кристаллическая структура с пр. гр. $P2/c$, проекция структуры вдоль оси b ; стрелкой показано направление магнитных цепочек с разной ориентацией ВС в слое (а), вдоль оси c ; стрелкой показана удвоенная трансляция вдоль оси a (б).

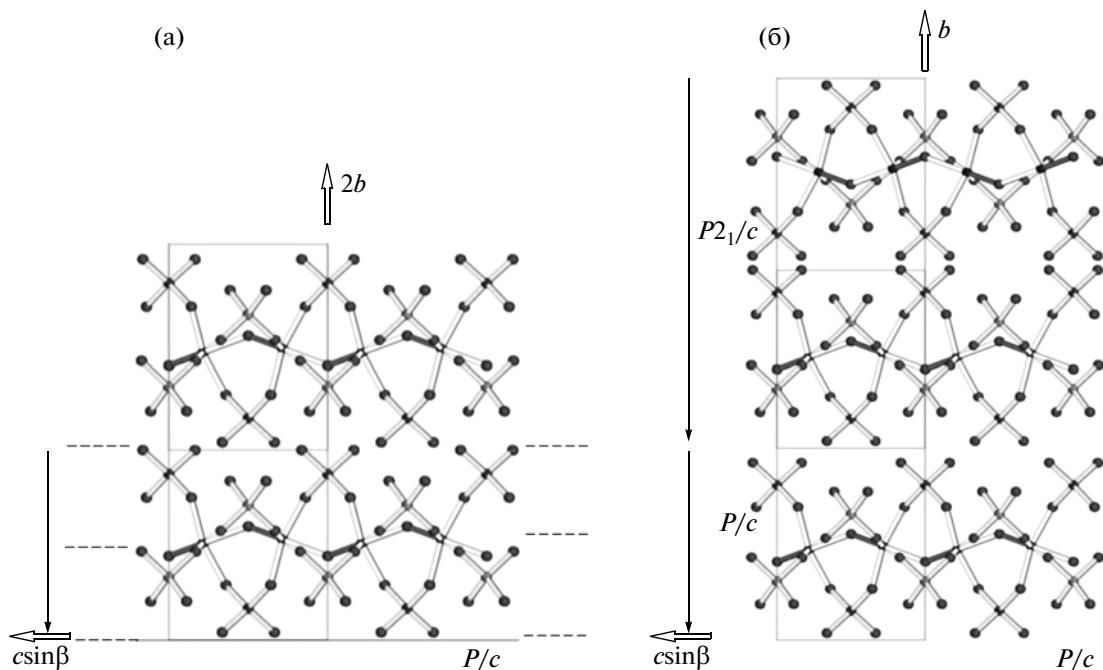


Рис. 4. Кристаллическая структура с пр. гр. Pc , проекция структуры вдоль оси a (а); аналогичная проекция для гибридной структуры с пр. гр. Pc с утроенным параметром b (б).

в цепочках друг на друга (рис. 5а), т.е. неполярным образом по сравнению с рассмотренными выше структурными вариантами. Размножение цепочек и слоев происходит в структуре также неполярно центрами инверсии. По аналогии с предыдущим можно вывести новую структуру с

пр. гр. $P2$ (рис. 5б). В ней один VO-слой с неполярными ВС будет размножен трансляционно вдоль оси b , при этом параметр ячейки $b_{\text{нов}} = 1/2b_{\text{исх}}$, как в предыдущем случае. Также можно составить комбинацию из двух фрагментов – структур, отвечающих пр. гр. $P2/a$ и $P2$. Ее сим-

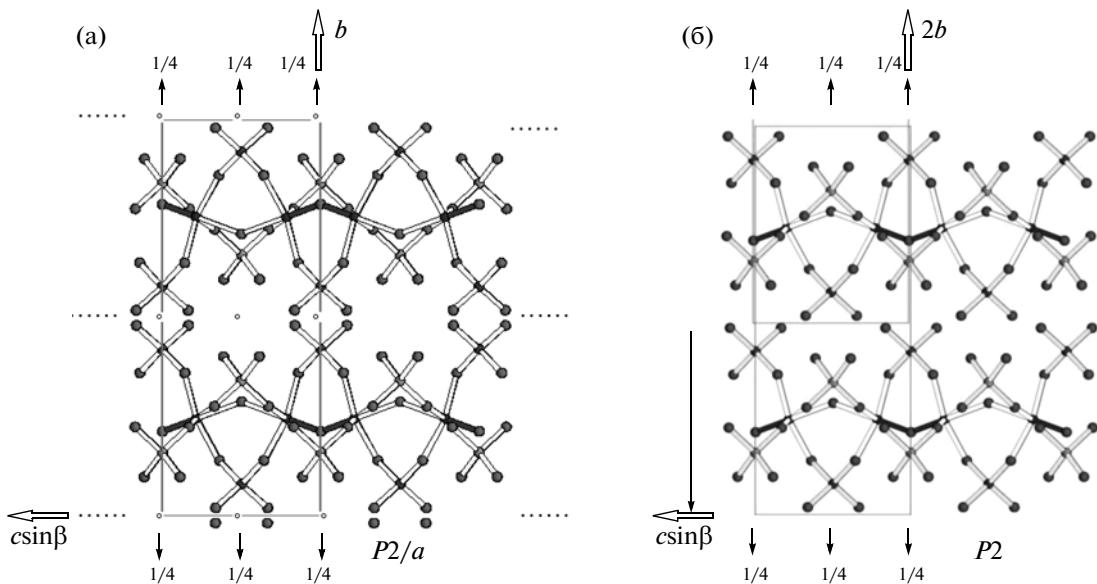


Рис. 5. Кристаллическая структура с пр. гр. $P2/a$, проекция структуры вдоль оси a (а); то же для структуры с пр. гр. $P2$.

метрия будет отвечать пр. гр. $P2$, $b_{\text{нов}} = 3b_3 = 1.5b_{\text{исх}}$. Рассмотренные структуры вновь демонстрируют проявление порядка—беспорядка вдоль одного направления, отвечающего оси b . Варианты с разупорядочением вдоль второго направления — оси a могут быть производными и от структуры с симметрией $P2$: вдоль оси a между октаэдрами могут быть не только поворотные оси 2, но и центры инверсии из надгруппы. Закономерное чередование осей и центров дает пр. гр. $P2/n$ с удвоенным параметром a (рис. 6). Простейшая комбинация структур $P2/n$ и $P2$ дает группу $P2$ для гипотетической структуры и параметр $a = 3a_{\text{исх}}$, также возможны более разупорядоченные варианты.

Кроме рассмотренных случаев нарушенного чередования либо по оси b , либо по оси a могут

существовать структурные модели, соединяющие оба типа беспорядка и дающие разнообразные и сложные суммарные картины распределения ВС.

Ориентация ВС в структурах рассматривается в [1, 2] во взаимосвязи с магнитными свойствами, поскольку отсутствие центра инверсии в октаэдре, упорядочение смещения магнитного иона и, как следствие, расположение ВС предопределяют возможность упорядочения $3d^l$ -электрона по спину, следовательно, в данном семействе структурное упорядочение коррелирует с магнитным. Смещение центрального магнитного иона в октаэдрах цепочек по антипараллельному закону $F(AF)$ с одинаковой ориентацией в цепочке используется в [2] для объяснения антиферромагнитных свойств: магнитные цепочки находятся в ac -плоскости и проходят перпендикулярно структурным цепочкам октаэдров через лежащие в слое немагнитные тетраэдры вдоль направления $a' \parallel (b \times c)$. Это имеет место в структуре с пр. гр. $P2_1/c$ или $P2/c$. В структуре с пр. гр. Pc ВС имеют одинаковую полярную ориентацию (F) в цепочках и во всей структуре и ту же ориентацию магнитных цепочек. В структурах второй подгруппы с пр. гр. $P2/a$ и $P2$ и их разупорядоченных комбинациях ВС ориентированы в цепочках друг на друга, то же характерно и для структур с группами $P2/n$, $P2$ и их комбинаций.

После завершения вывода структурных модификаций в семействе Sr-ванадил-ванадатов стало известно, что получены и исследованы разновидности для структур аналогичного семейства со свинцом, $Pb_2V_3O_9$ и $Pb_2As_2VO_9$ [6]. Структура $Pb_2As_2VO_9$ отвечает выведенной структуре с пр. гр. $P2_1/c$ с учетом иного выбора осей в дифракцион-

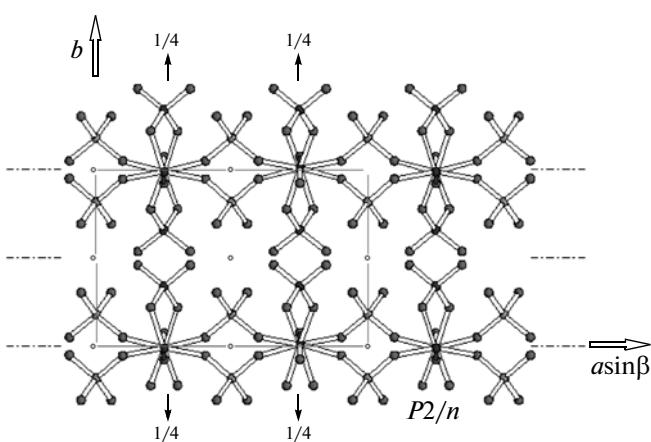


Рис. 6. Кристаллическая структура с пр. гр. $P2/n$, проекция структуры вдоль оси c .

ном эксперименте [6], а две модификации $\text{Pb}_2\text{V}_3\text{O}_9$ принадлежат подсемейству, в котором сохраняется только плоскость a из надгруппы $I2/a$ и отдельный слой полярен, как в предсказанной структуре с пр. гр. Pc . В отличие от последней параметр b ячейки не укорачивается вдвое, а сохраняется, что в свою очередь обусловливает возникновение решеточной C -трансляции. В структуре при высокой температуре реализуется пр. гр. Cc (в нашей установке было бы Ia). Для второй модификации при обычных условиях установлена структура с триклинной группой $C1$ (подгруппой Cc). В обеих структурах ВС упорядочены полярно “ферромагнитно”.

Исследование магнитных свойств в [6] проведено в строгом соответствии со структурными данными для каждого из Pb-ванадил-ванадатов. Оно показало, что $\text{Pb}_2\text{V}_3\text{O}_9$ (пр. гр. $C1$) обладает антиферромагнитными свойствами, в то время как для $\text{Pb}_2\text{As}_2\text{VO}_9$ установлены парамагнитные свойства. Рассмотрение обменных взаимодействий [6] привело к выводу о расположении магнитных цепочек аналогично [1, 2] и предположению о нахождении неспаренного $3d^1$ -электрона на d_{xy} -орбитали, что характерно для ванадильной группы. Экспериментальное исследование распределения электронной плотности по рентгendifракционным данным с уточнением мультипольных заселенностей позволило бы напрямую установить заселенность d_{xy} -орбитали неспаренным $3d^1$ -электроном иона V^{+4} , как это было установлено для антиферромагнитных структур, содержащих октаэдрически координированные ионы меди Cu^{2+} с расположением неспаренного $3d^1$ -электрона на $d_{x^2-y^2}$ -орбитали [7].

Из шести вариантов упорядочения спинов в суперячейке $2 \times 1 \times 2$, ферромагнитного F и пяти антиферромагнитных $AF(1-5)$, расчетом DFT [6] выделено наиболее выгодное антиферромагнитное упорядочение $AF4$. Оно может быть описано шубниковской группой симметрии, изоморфной исходной федоровской, с введением “реберной” черно-белой центрировки P' в направлении диагонали $[\bar{1}01]$. Все структуры выведенной второй подгруппы будут нестабильными в силу мостикового положения атома О между двумя ВС, как это указано в [6].

ВЫВОДЫ

Выполнен тополого-симметрийный анализ семейства структур Sr-ванадил-ванадатов $\text{Sr}_2\text{VO}(\text{VO}_4)_2$, и на основе соотношения группа–подгруппа предсказан ряд структур с различным упорядочением ванадильных связей. Для них даны параметры ячеек, пространственные группы и построены

проекции структур на основе предсказанных координат базисных атомов. Полученные результаты позволяют определять методами рентгеновской или электронной дифракции фазы данного семейства и идентифицировать структуру, для которой исследуются магнитные свойства. Правильность сделанных предсказаний подтверждается результатами в [6].

Выявленный закон строения показывает, что для структур семейства характерно разупорядочение в двух направлениях, что вполне может проявиться при получении новых составов. Как отмечено в [4], образование одной из упорядоченных в отношении распределения ВС структур с пр. гр. $P2_1/c$ возможно при длительном отжиге. Из [6] следует, что изменение химического состава фаз, например замена Sr на более крупный и тяжелый атом Pb, приводит к формированию новых разновидностей, которые, однако, могут быть получены на основе принципа группа–подгруппа и принадлежат общему структурному семейству. Формированию более “простых” структур с меньшими по размеру ячейками способствует как продолжительная кристаллизация, способствующая упорядочению, так и более низкие температуры, что согласуется с принципами формирования политипов. Высокие температуры и быстрая закалка будут приводить к образованию разупорядоченных структур с большими параметрами, вплоть до полного беспорядка вдоль осей b и a .

Авторы выражают признательность О. Ментре за возможность ознакомиться с результатами структурных и магнитных исследований семейства свинцовых ванадил-ванадатов и ванадил-арсената и сделанные ценные замечания, особенно в отношении структур с неполярной ориентацией ВС, а также рецензенту за замечания в отношении интерпретации магнитных свойств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kaul E.E., Rosner H., Yushankhai V. et al. // Phys. Rev. B. 2003. V. 67. P. 174417.
2. Ivanshin V.A., Yushankhai V., Sichelschmidt J. et al. // Phys. Rev. B. 2003. V. 68. P. 064404.
3. Feldman J., Muller-Buschbaum Hk. // Z. Naturforsch. B. 1995. B. 50. S. 43.
4. Черная В.В. // Синтез, структура и магнитные свойства сложных оксидов и оксофосфатов ванадия (III, IV). Автореферат дисс. канд. хим. наук. Москва. МГУ, 2010.
5. Dornberger-Schiff K. // Abh. Deutsch. Akad. Wiss. Berlin. 1964. B. 3. S. 2.
6. Mentre O., Koo H.-J., Whangbo M.-H. // Chem. Mater. 2008. V. 20. P. 6929.
7. Belokoneva E.L., Gubina Yu.K., Forsyth J.B., Brown P.J. // Phys. Chem. Miner. 2002. V. 29. P. 430.